



Title	反応性イオンビームエッチングを用いたGaASとAlGaAsのドライエッチングの研究
Author(s)	菅田, 純雄
Citation	大阪大学, 1990, 博士論文
Version Type	
URL	<a href="https://hdl.handle.net/11094/36958">https://hdl.handle.net/11094/36958</a>
rights	
Note	著者からインターネット公開の許諾が得られていないため、論文の要旨のみを公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、<a href="https://www.library.osaka-u.ac.jp/thesis/#closed">大阪大学の博士論文について</a>をご参照ください。

*The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA*

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

氏名・(本籍)	菅	田	純	雄
学位の種類	工	学	博	士
学位記番号	第	9021	号	
学位授与の日付	平成	2年3月14日		
学位授与の要件	学位規則第5条第2項該当			
学位論文題目	反応性イオンビームエッチングを用いたGaAsとAlGaAsのドライエッチングの研究			
論文審査委員	(主査) 教授 難波 進			
	(副査) 教 教 浜川 圭弘 教 授 蒲生 健次 教 授 高井 幹夫			

### 論文内容の要旨

GaAsとAlGaAsを用いたO E I C作成のためのドライエッチングの研究を行った。従来、組成の違いによりエッチング速度に差がある、レーザ端面の垂直側壁が形成できない、イオン衝撃による損傷が大きいなどの問題があった。これらの問題を解決すべく、プラズマ源に電子サイクロトロン共鳴(E C R)を用いた反応性イオンビームエッチング(R I B E)装置を開発した。本装置は高真空対応であり、また、プラズマ室とエッチング室が分離しており、引き出し電極でイオンを引き出すため、イオンエネルギーとガス圧が独立に制御可能である。エッチングガスは、低沸点化合物を生成する塩素ガスを使用した。

バックグランドが高真空であるため、残留ガスによるAlの酸化が抑制され、GaAs/AlGaAsの等速エッチングが達成された。更に、最適ガス圧、三層レジスト法によるマスクの使用により、垂直かつアスペクト比の大きいエッチングが達成された。これらの技術により半導体レーザ端面を形成した結果、へき開したものと同程度の特性が得られた。

また、イオン衝撃による損傷も大きな問題であるが、物理的スパッタの効果を抑え化学反応性を増すことにより、損傷が低減できることが解った。更に、“その場”熱処理が損傷回復に有効であることを確認した。また、イオン衝撃を避けた状態で塩素ラジカルが塩素分子に比べ多量に基板に吸着する事を確認した。この状態で基板を加熱することにより、結晶面方位依存性のあるエッチングが得られた。得られたファセット面は、化学反応のみによるエッチングであるため損傷が無いことが期待できる。更に、ラジカル量を制御した小型E C Rプラズマ源を用いたラジカルビームガンを開発し、GaAs表面のクリーニングを行った。水素ラジカルと水素分子とで比較した結果、ラジカルの方が化学的に活性で、クリーニング効果が大きかった。以上の結果より、低損傷エッチングを達成するには、ラジカルを有効利用し化学反応性

を増すことが重要であることがわかった。

## 論文の審査結果の要旨

光集積回路を実現するためには GaAs 系半導体材料の超微細加工技術を確立する必要があるが、従来のドライエッティング加工では、組成の違いによるエッチング速度の差異のため、半導体レーザー端面の垂直側壁が形成できない、イオン衝撃による損傷のため材料の光学特性が劣化するなどの問題があった。

本論文は、電子サイクロotron共鳴プラズマを用いた反応性イオンビームエッティング装置を試作し、上記諸問題を解決する新しい加工法を開発した結果をまとめたものである。

まず、GaAs と AlGaAs のエッチング速度の差異の原因が Al の酸化にあることを見い出し、高真空中での塩素の反応性イオンビームエッティングにより、垂直でかつアスペクト比の大きい鏡面エッティングの達成に成功し、この技術により端面形成した半導体レーザーがへき開端面のものと同程度のレーザー特性が得られることを示した。

次に、物理的スパッタを抑え化学反応性を増すことによりイオン衝撃による損傷の大幅な低減ができる事を示し、また塩素ラジカルのみによる基板加熱エッティングにより、化学反応のみによる無損傷ドライエッティングが可能であることを実証した。

これらの研究は光集積回路実現のための技術的基盤を与えるとともに、半導体プロセスの発展に大きな貢献をしている。よって工学博士論文として価値あるものと認める。